

INNOVATION NEXT

SEED Lab., Corporation

Providing innovative engineered solutions
for today's advanced science
and technology.



先端技術で時代をリードする カスタム真空機器のパイオニア

ご挨拶

より豊かな生活を得るために「礎」を願って

1981年、半導体開発に必須となる真空技術産業確立への期待と使命を担って、当社は誕生しました。以来、四半世紀、2006年に創立25周年という節目の年を迎えますが、これもひとえに皆様方からの広いご支援、ご愛顧の賜です。改めて心よりお礼申し上げます。

当社が設立された当時、国内の真空技術産業の市場と開発状況は、現在のように活発ではありませんでした。しかし、精度の高い半導体の製作やナノテクノロジー開発に不可欠となる優れた真空技術の確立を望む声は高まる一方であり、以来、25年間にわたって技術を磨き、ノウハウと実績を重ねてまいりました。その歩みはまさにパイオニアと呼ぶにふさわしいものではなかったかと、自負しております。

今後もこの姿勢を崩すことなく、「社会的に意義のある事業を開拓する」との自覚のもとで、発展する市場とともに次の成長を目指してまいります。

お客様に密着してさらなる向上に挑む

現在の当社があるのは、お取引いただいているすべてのお客様、弊社の技術が活かされている製品を身近な生活の中で活用されている消費者の皆様のお力添えによります。この事実を忘れず、製品品質の向上を企業課題として技術のさらなる向上を図るとともに、既存装置の品質を高いレベルに保つための取り組みを進めてまいります。

その際に大きな力となるのが豊かなパーソナリティを備えた若い人材です。また、企業として、より豊かな社会づくりに貢献することを考えた場合、技術力やノウハウの習得もさることながら、優れた人間性を備えた人材の育成こそが必要であると考えています。

科学技術の発展は、人々の暮らしをますます豊かなものにしています。当社は半導体・ICチップ・自動車部品・液晶等の製造に関与することで、さらなる豊かさの実現に取り組んでまいります。

皆様には今後も変わらぬご愛顧のほどをお願いいたします。

代表取締役 木下時重

当社は、真空技術のパイオニアとして長い実績を刻んできました。その歩みは、まさに日本の真空技術産業発展の歴史そのものであったと言っても過言ではありません。真空技術は、精度の高い半導体・ICチップの開発には不可欠の技術であり、現在は宇宙工学関連製品、半導体デバイス、電子部品、薬剤生成、光学レンズなどのコーティング、インスタント食品の製造過程で利用されるなど、様々な用途で活用されています。むしろ、私たちの日常生活で真空技術が利用されていない製品を見つけるほうが難しいかもしれません。つまり、当社の活動はそのまま人々の暮らしを豊かにすることに直結しているのです。そのため当社では、企業市民の一員として社会の中で皆様と共に存し、貢献していくことを最大の理念としています。

その上で、独創性を重視し、絶えずお客様の立場に立ち、お客様のご要望に最大限お答えするように、誠心誠意尽くしてまいります。当然、品質については最優先で取り組んでおり、常に品質の向上を最重要視しています。これはお客様によって当社が存続し得ている以上、極めて当然の義務だと考えております。また、真空技術を応用した業務を通じて社会貢献することの重要さを念頭に置き、新たな技術の開発に挑戦していきます。さらに、より優れた「ものづくり」企業は、よりよい人間性を備えた人材の育成の上にこそ成り立つと考え、人材の教育に力を入れています。私たちの事業成果は、このような方針のもとにこそ「社会の皆様の生活の場に還元されうる」のであり、その信念のもとで事業を続けてまいります。

より豊かな暮らしを人々のために 当社の技術は社会と共にあります

社会に貢献し、人々を豊かにする 「先端技術」の開発

技術とは常に進化していくものです。その目指すところは「社会への貢献」であるべきだと当社は考えています。当社の真空技術は、エレクトロニクスの領域にとどまらず、21世紀のこの社会のあらゆるところで活かされています。もちろん、先端技術とはゼロから生まれるのではありません。過去の技術を改良することから進化は生まれます。つまり、過去の技術を知ることが次の技術躍進につながるのであり、その意味でも常に社会と密接に関わりを持つことによって技術のあり方というものを学んでいかなくてはならないと考えています。また、多くの場合、技術躍進が社会の発展に大きく貢献することから、今後とも、当社は自分たちの技術にさらに磨きをかけてまいります。

Consumer Orientation

お客様との共存共栄を目指す 「顧客志向」の姿勢

企業にとって大切なことは、社会の一員として自らを律することです。特に「ものづくり」の場合、お客様からのフィードバックがあってこそ改良が生まれ、次の技術の進化に結びつくのです。いわば、企業とはお客様によって生かされているのであり、お客様の力添えがあってこそ発展が可能になります。従って私たちの基本にあるのは、お客様との共存共栄の思想です。あらゆる課題を真摯に受け止め、広い視野で問題の本質をとらえ、その解決に全力で取り組んでまいります。その思いがあるからこそ、私たちの挑戦には終わりがありません。これからも当社は絶えずお客様の立場に立ち、お客様のご要望にお応えできるよう誠心誠意を尽くしてまいります。

協調性と独創性を持つ人材による 「チーム力」の強化

Team Work

優れた企業は、優れた人材がいてこそ成立します。人材こそ企業の最大の財産です。当社が人材面で基本としているのが、協調性と独創性を有する人材の確保です。仕事とはチームで行われるものであり、同時に、お客様との良好なリレーションが絶対に不可欠ですから、協調性を保ちながらコミュニケーションできる力が必要とされます。また、画期的な製品を生み出す技術力を磨くためには、常に独創的な視点・発想を忘れてはなりません。こうした資質を有する人材が集まり、チームワークを発揮することで、当社は成長してきました。この姿勢に変わりはない、これからも当社は優秀な人材の採用、及び、教育には特に力を入れてまいります。

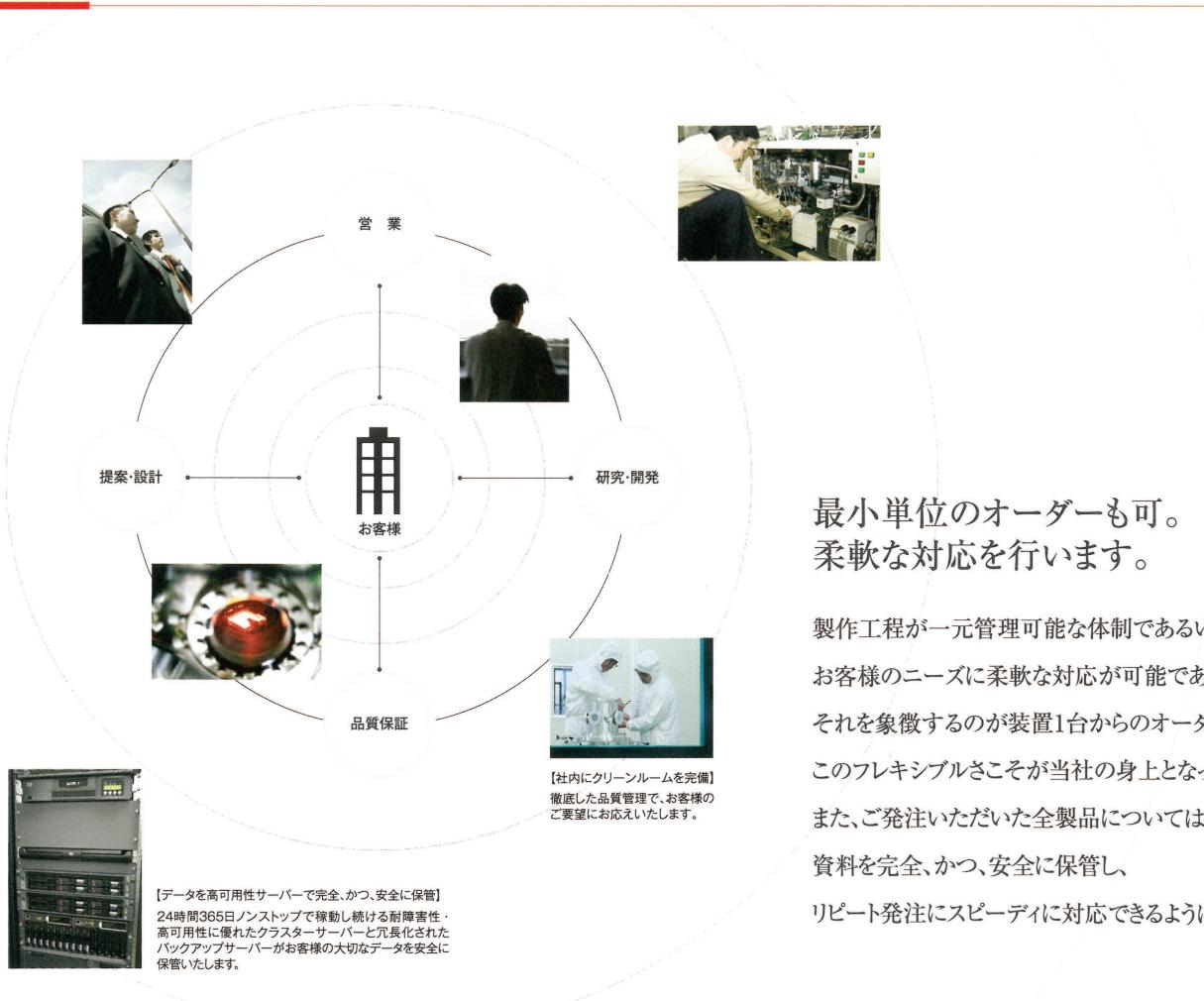
Mission

Advanced Technology

前述にありますように、今日のあらゆる生活場面において真空技術は活用され、よりよい社会づくりに貢献しています。それゆえに、技術を提供する側である当社にとって、ご要望いただいた依頼内容をできるだけ短期間で実現する体制を確立していくことは、重要な社会的使命であると考えています。このような思いのもと、当社ではお客様のニーズに確実にお応えすべく、充実したサービス体制を構築しています。それは、25年という長い期間にわたって真空技術の開発に挑んできた当社ならではの体制でもあります。具体的には、部門間の連携の良さ、自社内での製造工程の一元管理、単品からのカスタムメード装置製作など、小規模な企業の特性を最大限活かして事業を展開しています。

柔軟、かつ、迅速な対応が可能であり、現場での刻々と変化する状況にもスピーディに対応いたします。いわゆる「小回りの良さ」が当社の身上でもあるのです。また、設計から製作までほぼ自社内で把握可能な工程の一元管理体制と、1台からのオーダーメード装置製作が可能であるという製造現場での柔軟性を活かし、様々な応用実験装置の開発を行っています。このような「小回りのよい」サービスをご提供させていただくことにより、お客様により満足度の高い製品をお届けすることが可能になっております。実際の開発の際は、専門的な知識とスキルを持った技術営業、専門技術スタッフがお客様と直接お話をさせていただきます。そのため、話の行き違いといったリスクもなく、確実にニーズにお応えする製品をつくりあげることができます。

一元管理された事業体制を確立 柔軟、かつ、スピーディな対応が可能です



信頼のサービスを、いつでも迅速に。 お客様最優先の体制を貫いています。

真空技術をベースとして幅広い領域で事業を展開している当社では、「スピード & クオリティ」をサービスの基本としています。お客様からのお問い合わせには極めて迅速に対応。綿密な打ち合わせを行った後、専門技術者を派遣して「ニーズに即した提案に結びつける」といった、お客様最優先のサービスを提供しています。

サービスの特徴

ダウンタイムの削減・

お客様側で生じたダウンタイムは、非常に大きな作業時間の損失につながります。当社では万一の際でも影響を最小限に抑えられるよう、ダウンタイムを極力減らすべく迅速に対応いたします。

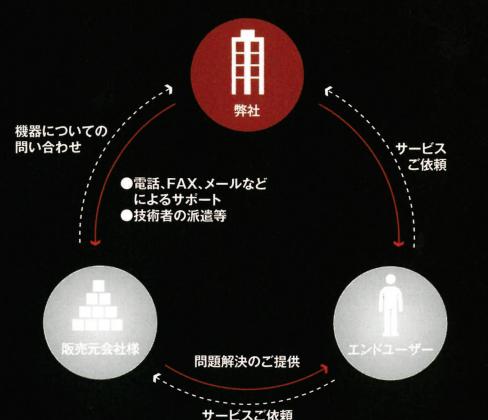
綿密な準備と対応・

メンテナンス等も含め、あらゆるサービスの提供に際しては事前に入念な準備と打ち合わせを行います。そのためトラブルのない、満足度の高いサービスをお届けすることが可能になっています。

トラブルの際も安心・

緊急トラブルの際は遠方であっても技術スタッフを現地に即時派遣。生産ラインの早急な復旧に努めます。定期メンテナンスについても専門スタッフが作業を行う体制を整えています。

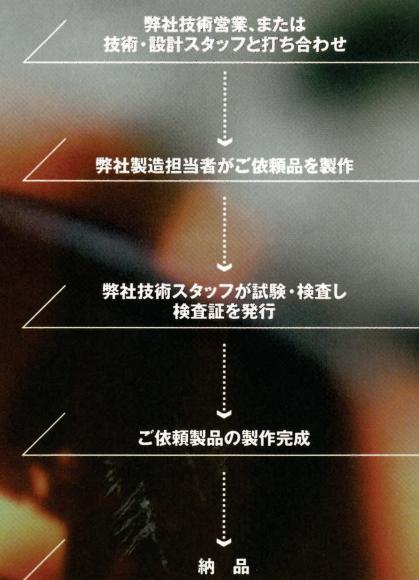
サービスの体制



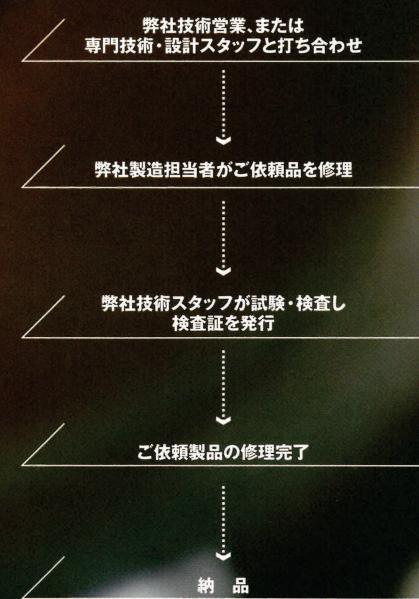
- 弊社の製品をご購入いただいたお客様に対してのアフターサービス・メンテナンスは、弊社、ならびに、販売元会社様からご提供いただきます。
- 直接、弊社とご契約いただいたお客様に対しては、弊社の技術・製造の各部門がサービス・メンテナンスにあたさせていただきます。
- 弊社によって、既に設置されている大型機器に不具合、故障が発生した場合は、ご相談のうえ整備・改良にて、対処させていただきます。
- 故障・不具合が認められる真空ポンプ、真空バルブ等は、メンテナンス、あるいは、オーバーホールの対象となります。

サービスの流れ

新規依頼の場合・



修理依頼の場合・



• 主な製品ラインナップ

受注をいただいたお客様からの要望は100%実現させています。

私たちの成長と挑戦の歴史がここにあります。
今後もさらに次の成長を目指してまいります。



自由な発想が生かせる
オーダーメイド成膜装置



■薄膜形成／スパッタリング

ジョセフソン接合素子作製装置(JW-003)

超高真空技術をベースとして設計された直流スパッタ装置です。本装置は、活性金属薄膜を必要とするLSIレベルのニオブ/アルミ酸化物/ニオブ構造のジョセフソン集積回路の成膜に最適な設計となっています。また、アルミ成膜室とニオブ成膜室を、常時、清浄な高真空状態に維持することによって、高品質のジョセフソン接合の作製を実現します。



■薄膜形成／スパッタリング

抵抗薄膜作製装置(SPR-014)

超伝導集積回路作製時に必要な抵抗薄膜を基板上に堆積させるための成膜装置です。本装置は、基板に抵抗薄膜を堆積させるための成膜室、試料交換室、および、制御部から構成されています。試料交換室—成膜室間での試料搬送・基板交換は、ロードロック機構によって行われます。また、外部コンピューター制御により、3元スパッタ蒸着も可能な設計になっています。



■薄膜形成／化学蒸着

光化学蒸着装置(CHV-401P)

本装置は、ガラス基盤の片面に3層成膜を行う装置です。蒸着方法として、光CVD方式とプラズマCVD方式の両方を採用。また、プロセスチャンバー3室と試料挿入のためのローディングチャンバーを直列に配置することによって、作業の効率化を図りました。これに加えて、CVD成膜に不可欠なガス供給部とガスを安定排気させる排気部を装備し、信頼性の高い作業環境を実現しています。



■薄膜形成／電子ビーム蒸着
超高真空蒸着装置Ⅱ(SEU-04)

UHV領域下で新しい物性や機能を持つ薄膜材料の作製を目的とした蒸着装置です。蒸発室には、3元蒸発源(3連電子銃1台、クヌードセンセル2台)を装備し、3元同時蒸着と2元自動交互蒸着が可能です。蒸着源直上には、水分圧を低く抑える液体窒素シュラウドのほか、蒸発源間のクロスコンタミネーションを防ぐ防着板を設置。さらに、蒸着室にはターボ分子ポンプ、チタンゲッタポンプ、電子銃監視窓・真空計・分圧計を装備。蒸着室上部には基板ホルダーならびに基板の温度制御が可能な基板ホルダー機構を搭載しています。



■薄膜形成／電子ビーム蒸着
電子ビーム蒸着装置Ⅰ(SEJ-04)

電子ビーム加熱によって高融点金属の蒸着を可能にする蒸着装置です。本装置の電子銃・ルツボ・排気ポンプ・膜厚センサーは、用途に応じて入れ替えが可能です。排気部にはクライオポンプ、または、ターボ分子ポンプを装備し、クリーンな作業環境を提供します。さらに、排気部・蒸着部の動作状態を自動でディスプレイ表示し、確実な作業環境を実現しました。



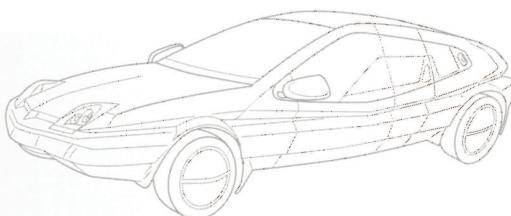
■薄膜形成／物理蒸着
Au単結晶薄膜作製装置(ESE-11)

高真空領域で基板上に金属(Au)を堆積させるための高真空蒸着装置です。蒸着は、4インチホルダーに固定された基板に、タングステンバケット上のAuを加熱蒸着することによって行われます。また、基板を高温に保ちながら、膜厚を水晶振動式膜厚計で制御し、極めて均一な蒸着を可能にしました。排気には、磁気浮上式広帯域ターボ分子ポンプ、および、油回転ポンプを使用し 1×10^{-6} Pa以下の高真空を達成します。



■薄膜形成／物理蒸着
大規模集積回路用 金属蒸着装置(ESE-09)

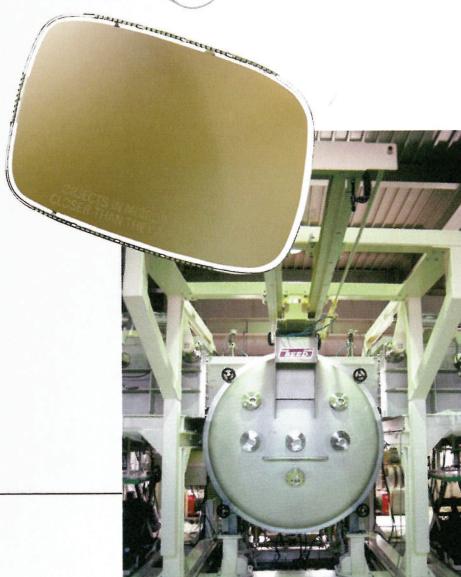
高真空領域での使用を目的とした蒸着装置です。本装置では、ウェーハを軸公転させる機構を装備することにより、極めて均一な膜厚分布が可能になりました。また、蒸発源には、抵抗加熱方式を採用し、アルミに対して実用耐久性のあるBNコンポジットを使用。膜厚コントロールは、水晶振動式膜厚計を用いた信号制御により、シャッターを自動駆動させることによって行われます。さらに、ドライな真空状態を得るため、磁気浮上式広帯域ターボ分子ポンプとドライポンプを使用した組み合わせ排気システムを採用しています。



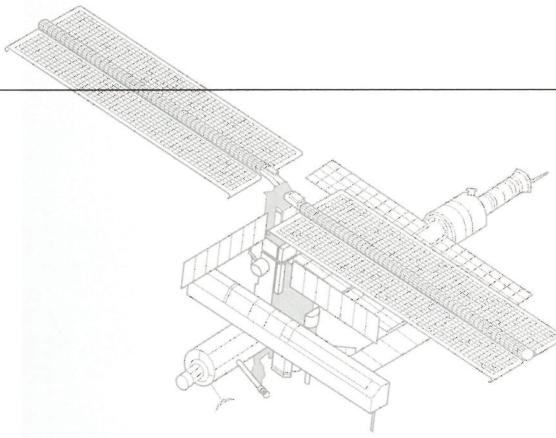
安全と快適を支える

ECミラー 3室連続蒸着装置

より安全で快適な運転環境を実現するのが、通常「防眩ミラー」と呼ばれるEC(Electro Chromic)ミラーです。このミラーは、電圧を印加した際に現れるEC層の酸化還元反応を利用することにより、光の反射率を可変させることができます。このミラーが持つ特性が、日差しの強い日中の太陽光や後方からの強いライト照射によって引き起こされるドライバーのブレインド現象を解消するため、高級車を中心に搭載が進んでいます。当社ではこのECミラーの製作に際し、コーティング不良を極力抑える設計を実施。また、電子ビームによる多層膜蒸着を3室でローテーションすることにより、24時間ノンストップ運転を可能にしました。



宇宙での実験を支える



■薄膜形成／物理蒸着
蒸着装置(ESE-06)

抵抗加熱式の蒸着装置です。本装置の真空排気部は、ターボ分子ポンプと油回転ポンプの組み合わせにより、 1×10^{-4} Paまでの排気が15分以内で可能な性能を備えています。また、蒸発源に、抵抗加熱方式を採用。スイッチの切り替えにより、3種類の物質の蒸着が可能です。さらに、蒸着電極に独立2点式を使用しているため、同時2種蒸着が行えます。



■薄膜形成／イオンプレーティング
イオンプレーティング実験装置
(IPE-101)

様々な治具・工具にコーティングを施すことを目的に開発されたイオンプレーティング装置です。本装置は、大口径丸型容器を使用し、電流端子導入用ポート・治具導入用フランジ等を装備しています。蒸発源には、電子銃・ルツボを配備し、基盤収納部には加熱ヒーターを設けました。また、排気部には、ターボ分子ポンプと油回転真空ポンプを使用したコンビネーション排気を採用しています。

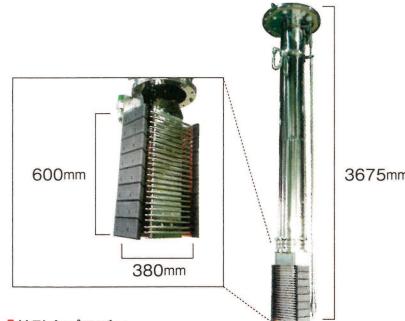


■核融合プラズマ
高速移動プローブ(PIM-90P)

トロース/ヘリカル型放電管内のプラズマ分析を可能にした高速移動プローブです。本装置は、アダプターを介し、口径35mm以上のポートに設置が可能になっています(設置の際の水平度、垂直度、傾斜度、いずれも調整が可能です)。また、駆動部は最大600mmまでのリニア移動、プローブ部は50mm/40m secまでの超高速移動が可能な設計になっています。



核融合関連のデータ処理を
こなす駆動実験装置



■核融合プラズマ
高周波ICRFアンテナ(ANT-010)

プラズマ加熱源として用いられる高周波を導入するためのICRFアンテナです。本装置は、数十メガヘルツ・3メガワットの出力性能を備え、長時間の安定した運用を実現します。また、構造上、大型ながらもアンテナ部の組み込み・解体が容易な設計になっています。



高真空から極高真空中に
対応する真空排気装置



■真空排気装置
ターボ分子ポンプ排気装置(PUD-200)

信頼性の高いコンパクトな多目的ドライポンプ排気システムです。本装置は、操作性に優れ、長期間の使用に耐える設計になっています。また、使用用途に合わせ、電源電圧をお選びいただけます(100V/200V)。



■真空排気装置
真空排気装置(VPS-050)

放電実験・真空蒸着といった比較的簡単な実験での使用に適している取扱が容易な真空排気装置です。



数々の分野で応用可能な
高精度真空装置



■各種装置
瞬時加熱反応装置(RHF-0020)

反応性原料ガス分子の表面吸着と反応現象を応用し、原子レベルでの制御を可能にした超薄膜作製装置です。本装置は、高周波誘導加熱方式を採用し、変動の少ない基板温度制御を実現しました。また、窒素ガスバージ機構を装備し、反応室への水分混入を阻止。ロードロック室^(*)を装備し、反応室を真空状態に保ったまま、基板のロード・アンロードが行える設計になっています(*オプション)。



■各種装置
スペースチャンバー(SPI-301)

宇宙空間でのイオン計測機器の試験を目的とした真空環境試験装置です。本装置は、スペースチャンバーとイオン加速装置から構成されており、スペースチャンバー内の圧力を 2.7×10^{-6} Paまで真空排氣することができます。また、イオン加速管には最大+150KVの高電圧を印加。スペースチャンバー内に設けられている回転ゴニオステージ上の供試体へのイオンビーム照射が可能です(直径約φ1400)。



■各種装置
クリーン焼成装置(SAF-001)

高真空排氣(最大排氣能力： 5×10^{-6} Pa)された石英製反応管内に気体(窒素・空気など)を流し、加熱(最大加熱温度700°C)を行う実験装置です。試料は、5インチガラス平板を8枚まで装填可能。平板内温度、 $600^{\circ}\text{C} \pm 3^{\circ}\text{C}$ を維持できる性能を備えています。また、石英管の取り出し方法の簡易化、異常加熱時の電源停止などメンテナンスと安全性を考慮しました。

各種部品

各種装置に互換性のある信頼性の高い真空部品



■各種部品／超高真空部品
超高真空対応覗き窓シャッターII
(STW-002)

真空応用機器に装備することを想定して設計された、作業覗察窓用シャッターです。本製品の使用により、覗察窓表面に生じやすい結露、光照射による高温化等を防ぐことが可能です。また、超高真空領域・高磁場での作業にも対応しています。



■各種部品／超高真空部品
超高真空ポリイミドL型バルブ
(VUL-114HP)

超高真空領域での使用を前提に開発されたポリイミドバルブです。バルブディスクには、板状ポリイミドガスケットを採用しました。また、ガスケットは全開放状態で 300°C までのベーリングが可能です。本装置は、シール材にバインを使用したバルブと比較すると耐熱性に優れ、シールトルクも低く抑えられた(50Kg ~ 75Kg/cm)仕様となっています。



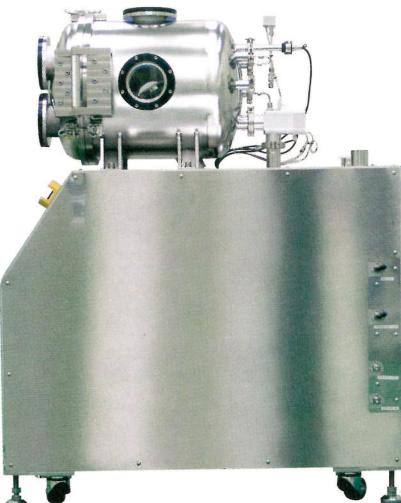
■各種部品／真空部品
磁気結合型トランスファーロッド
(STR Series)

トランスファーロッド内部に配置されているホルダー等の移動にマグネットカップリング方式を採用した試料搬送機構です。これにより、軸回転時、水平移動時のリーケ率を極めて低く抑えることに成功。超高真空領域での使用を可能にしました。また、5種類のサイズの中から、作業状況に最適なものをお選びいただけます(200、400、600、800、1000mm)。さらにオプションにより、特注サイズ、モーター駆動使用、位置出し用ペローズジョイント装備などのカスタマイズが可能です。



■各種部品／真空部品
試料加熱系・LN冷却系(HC-004)

加熱による試料面のクリーニングを行う装置です。本装置の過熱部周辺は、熱の拡散を防ぐために、シールドされています。シールド板には、鏡面研磨を施したものを使用。試料への熱伝達率を極限まで高めました。制御部は、温度調節器・電力調節器・出力レベルメーター・電流上限設定ボタン・シャルメーター・電源スイッチで構成。温度調整には、被加熱物の温度を熱電対で検出し、ヒーター電流を制御する方式を使用し、冷却には液体窒素冷却方式を採用しました。これにより、L-Nレベルの変化時にも試料温度を一定に抑えることが可能となりました。



■各種部品／真空部品
真空液晶脱泡装置

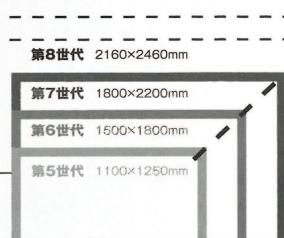
液晶材料から短時間で空気を除去する装置が、当社の真空脱泡装置です。独自開発された機構を使った1軸だけの攪拌により空気除去が可能で、液晶パネル製作の歩留り向上に大きく寄与します。

液晶の進化を支える

真空排気システム

液晶パネルは、年々大型化が進んでいます。その製作装置に組み込まれているのが、当社の真空排気システムです。液晶パネルの張り合わせ工程では様々な真空ポンプや、精密洗浄された真空配管が利用されています。その真空排気システムの設計には、配管と配管の間に生じるコンダクタンスの追求などが必要です。当社では、これまでの実績に裏づけられた技術力を駆使し、第7世代パネル製作に対応可能な真空排気システムを実現しています。

▼大型液晶パネル世代別



有機ELパネル

有機ELディスプレイパネルは、電気を光に変換する原理を利用して製作され、室外でも明るい・応答速度が速いなどの特徴を持っています。

有機ELパネル製作用枚葉式蒸着装置

複数の真空成膜室と各成膜室間を移動する搬送用ロボットを備えた枚葉式蒸着装置です。高真空状態の膜成長室内では、分子線セルによる多源同時蒸着や繰り返し蒸着による合成層、および、多層成膜を行うことが可能なため、有機薄膜、ならびに、金属薄膜の作製に適しています。また、電子ビーム蒸着、抵抗蒸発源を使用した蒸着、スパッタリングを使用し、金属・SiO₂薄膜を作製することができます。



業績・

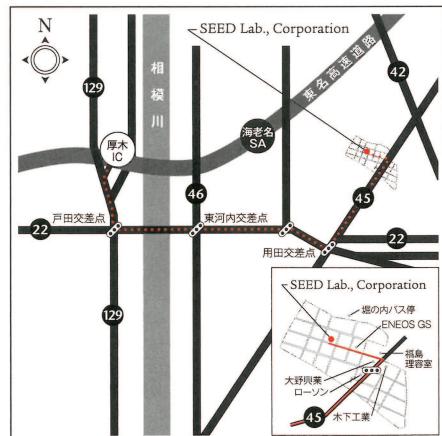
年 度	産 業 分 野	技 術 領 域
1981-1982年	電 子 工 業 公 害 研 究	排気系 分析機器
1983年	理 化 学 機 器 電 子 工 業	表面分析 イオンプレーティング装置、排気系
1984年	未 来 产 業 宇 宙 研 究	プラズマCVD装置、ドライエッチング装置 研究装置
	電 子 工 業	スパッタリング装置、イオンプレーティング装置、イオンミリング装置
1985年	工 学 工 業 電 子 工 業	MOCVD装置、スパッタリング装置 CVD装置、イオンエッチング装置、エビタキシャル成長装置
1986年	宇 宙 产 業 電 子 工 業	ECR-CVD装置、流体応用物理実験装置 超清浄CVD装置
1987年	電 子 工 業 自 動 車 产 業	UHV多元蒸着装置 ミラー製造装置
1988年	核 融 合 研 究	センサー機器
1989年	核 融 合 研 究 未 来 产 業	高速移動プローブ 光化学蒸着装置
1990年	核 融 合 研 究 電 子 工 業	電子ビームによる磁気測定装置 ロールコータ
1991年	新 分 野 開 発 核 融 合 研 究	ジョセフソン接合素子作製装置、食品加工用高圧処理装置 高周波ICRFアンテナによるプラズマ加熱
1992年	核 融 合 研 究 電 子 工 業 素 材 产 業	高耐電圧リミタ二次元装置 超高真空蒸着装置、枚葉式CVD装置、スパッタ薄膜装置、枚葉式エビタキシャル装置 電子ビーム蒸着装置
1993年	新 分 野 開 発 材 料 研 究 電 子 工 業 電 気 通 信 自 動 車 产 業	ジョセフソン接合素子作製装置 クリープ疲労試験装置、水素透過特性評価装置 集積回路用絶縁膜作製装置 スペースチェンバー 大型プラズマ処理装置
1994年	エネルギー研究 電 子 工 業 自 動 車 产 業	真空パルプ 物性評価装置 ECミラー 3室連続蒸着装置
1995年	核 融 合 研 究 物 理 研 究 エネルギー研究 材 料 研 究 電 子 工 業	直線中型駆動機構、磁力線追跡装置 He高純度精製装置 特殊ゲートバルブ、真空散乱槽 フロンティアセラミックス薄膜装置、表面界面制御装置 特殊真空容器、電子ビーム蒸着装置
1996年	核 融 合 研 究 理 化 学 研 究 未 来 产 業 電 子 材 料 電 子 工 業 自 動 車 产 業	磁気面計測用画像処理システム 金単原子作製装置、CVD/RFスパッタ成膜装置、耐食試験装置 金属接合装置、プラズマCVD装置 大規模集積回路用金属蒸着装置、クリーン焼成装置 アニーリング装置、プラズマCVD装置 プラズマ発生装置
1997年	未 来 产 業 電 子 工 業 自 動 車 产 業 表 面 处 理	ジョセフソン接合素子作製装置、FLASH-CVD装置、酸化物多層膜スパッタ装置 リソグラフィ用チャンバー ECミラー 3室連続蒸着装置2号機、2元EB蒸着装置 イオンプレーティング装置、小型プラズマ処理装置
1998年	核 融 合 研 究 材 料 研 究 電 子 工 業 表 面 处 理	磁気面計測装置 超高真空中固体精製装置、プラズマ重合実験装置、加速中性子検出装置、高温炉 導電材料成膜装置、抵抗薄膜作製装置、ECRエッチング装置、プラズマ重合装置、高真空薄膜作製装置、トランസフーシステム 電極表面処理装置
1999年	材 料 研 究 電 子 工 業	高精度照射誘起変形試験装置、RFスパッタリング薄膜装置 リソグラフィ用超高真空評価装置、自動蒸着装置
2000年	材 料 研 究 電 子 工 業 自 動 車 产 業 表 面 处 理	高温域水素透過特性評価装置、ディグレーダ、混合加熱器・水蒸発器 高真空トンネル電流測定装置、高清浄プラズマ反応炉、電子ビーム蒸着装置、ベーキングユニット、リソグラフィ装置チャンバユニット ECミラー 3室連続蒸着装置3号機 小型プラズマ処理装置
2001年	材 料 研 究 電 子 工 業 表 面 处 理	プラズマ重合装置、水素透過性評価装置 サブディフレクタ装置、電子銃用チャンバー、平行平板型3元高温スパッタ装置、真空剥離試験装置、有機ELパネル製作用枚葉式蒸着装置、小型蒸着装置 小型プラズマ処理装置
2002年	核 融 合 研 究 产 業 機 械 自 動 車 产 業 通 信 情 報 产 業	ループアンテナセンブリー LCD作製用真空排気システム 水素透過性能試験装置 平行平板型3元高温スパッタ装置用ロードロック室、真空蒸着装置(スパッタエッチング装置)
2003年	产 業 機 械 物 理 实 驗 加 速 器 通 信 情 報 产 業	真空液晶脱泡装置、LCD作製用真空排気システム Au単結晶薄膜作製装置 Xバンド用導波管 ロードロック式スパッタ装置改造
2004-2015年	产 業 機 械 电 子 工 業 核 融 合 研 究 材 料 改 质	LCD作製用真空排気システム、真空加熱炉(1400°Cタイプ、2400°Cタイプ) 超導線材用中間層薄膜作製装置、次世代リソグラフィ用評価装置、熱CVD装置 核融合実験装置用ダイバータ試験機 大型超高真空加熱炉(1000°Cタイプ)



株式会社日本シード研究所 SEED Lab., Corporation

【設立】1981年(昭和56年)6月12日
【創業】1981年(昭和56年)8月17日
【資本金】1000万円
【本社】〒252-1125 神奈川県綾瀬市吉岡東 2-3-27
【Tel】0467-77-4351(代表)
【Fax】0467-77-9858

【Map】



【Access】

電車・バスでの経路 ●
小田急線「海老名駅」東口で降りた後、「3番バス乗り場」から「吉岡芝原行〔緑11〕」に乗車。堀の内バス停下車後、南西方向へ。(堀の内バス停より、徒歩5分)

お車での経路 ●

東名高速「厚木IC」で降りた後、「国道129号線」から厚木市内へ入り、「22号線」を走行。用田交差点で左折、「45号線」を北東方向へ。(厚木ICより、約40分)
又は、圏央道「海老名IC」で降りて綾瀬市内へ。(海老名ICより、約30分)

